

КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інститут є головною організацією Наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої» при ВФА НАН України. Голова Наукової ради – академік НАН України В.Ф.Мачулін.

Організаційно Наукова рада складається з секцій за основними напрямками наукових досліджень у галузі фізики напівпровідників, а також регіональних семінарів (Київ, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Чернівці, Ужгород).

Як головна організація цієї Наукової ради, Інститут бере участь у організації та проведенні конференцій, симпозіумів, виставок та семінарів. Особлива увага при організації та проведенні конференцій приділяється новим актуальним напрямкам у фізиці напівпровідників. Експерти ради рецензують науково-дослідні роботи за відомчою тематикою НАН України.

Інститут є базовою організацією Українського товариства з оптичної техніки. В Інституті діє унікальна бібліотека праць цього товариства (понад 6000 томів), яка обслуговує провідних фахівців і наукові організації багатьох міст України. Інститут також є базовою організацією Українського відділення міжнародного товариства дисплейної техніки – SID. Проводиться організаційна робота заради об'єднання вчених і спеціалістів, що працюють в області інформаційних технологій. В Інституті створено бібліотеку праць SID, яка містить повну збірку матеріалів всіх міжнародних конференцій з дисплейних технологій та фізики рідких кристалів: всього 150 журналів за період з 1995 по 2010 роки.

Створений в Інституті комунікаційний вузол мережі INTERNET по виділеному швидкісному каналу зв'язку з зарубіжними інформаційними центрами забезпечує обслуговування приблизно 400 абонентів в e-mail, 400 абонентів в INTERNET, які можуть відправляти та одержувати електронну пошту, брати участь в електронних конференціях, знаходити та отримувати інформацію з баз даних: STN International, SPIE, іноземних бібліотек, інститутів, університетів тощо.

В Інституті діє електронна бібліотека, яка містить журнали Optical Engineering, Biomedical Optics, Electronic Imaging.

В Інституті працює наукова бібліотека, яка у своєму фонді налічує понад 172 тис. примірників друкованих видань. Книжковий фонд складає понад 23500 іноземних та вітчизняних примірників. До складу бібліотеки входять періодичні видання: іноземні - понад 55700 прим., вітчизняні –

понад 66400 прим., а також фонд видань, що продовжуються - понад 6400 прим., автореферати - понад 7000 прим., дисертації - понад 190 прим., мікрофіші - приблизно 2000 прим. Вся література, яка надходить до бібліотеки, відображається у довідково-пошуковому апараті, до складу якого входить інформаційно-бібліографічна картотека. Бібліотека випускає інформаційні списки літератури за тематикою відділів Інституту.

В Інституті працює науково-технічний архів, в якому зберігаються документи на паперовій основі постійного і тривалого зберігання, утворені у діловодстві структурних підрозділів Інституту.

В Інституті діють наукові збори, на яких заслуховуються наукові доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, а також матеріали докторських дисертацій.

Спільні наукові роботи проводяться з ВНЗами України, зокрема, з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Ужгородським національним університетом та Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича, національним університетом «Львівська політехніка», Житомирським державним університетом ім. Івана Франка, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Полтавським та Бердянським педуніверситетами, Кам'янець-Подільським державним університетом.

На базі Інституту діє філія кафедри оптики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На даний час в Україні вдалося зберегти провідні наукові школи з фізики в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Чернівцях, Ужгороді та інших містах. Провідні наукові колективи працюють в актуальних фундаментальних та прикладних напрямках сучасної фізики. Позитивним моментом роботи конференцій є помітна участь в них молодих вчених. Подальше розширення участі молоді у фізичних дослідженнях та прикладних розробках є першочерговим завданням на майбутнє.

Академіки НАН України С.В. Свєчніков, М.П. Лисиця, В.Ф.Мачулін, члени-кореспонденти НАН України О.Є. Беляєв, М.Я. Валах, Є.Ф. Венгер, В.С. Лисенко, В.Г. Литовченко, П.Ф. Олексенко, Ф.Ф. Сизов, професори В.О. Кочелап, Ф.Т. Васько, О.І. Власенко, І.В. Прокопенко, В.М. Томашик та інші науковці Інституту є членами редколегій міжнародних і зарубіжних періодичних наукових видань.

З метою популяризації науки в суспільстві та впровадження її досягнень у виробництво, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України брав участь у представницьких заходах, організованих НАН

України, Кабінетом Міністрів України, профільними міністерствами, відомствами та Київською міською державною адміністрацією:

У 2007 р.:

- «ЦеБІТ-2007», м. Ганновер, Німеччина;
- «Hannover Messe-2007», м. Ганновер, Німеччина;
- Загальнодержавна виставкова акція «Барвіста Україна», м. Київ,
- Міжнародна виставка систем та засобів безпеки «Безпека- 2007», м. Київ;
- В рамках Міжнародного форуму лабораторного, оптичного та аналітичного обладнання проходила виставка «Київ Оптика Тех-2007», м. Київ,
- Спільна виставка НАН України та Київської міської державної адміністрації «Наука — виробництву», м. Київ.

У 2008 р.:

- III міжнародна виставка «КиївОптикаТех-2008», м. Київ, 1-4 квітня 2008 р.;
 - Міжнародна виставка-ярмарок промислових технологій, м. Тріполі (Лівія), 1-12 квітня 2008 р.;
 - Спільна виставка НАН України та КМДА «Наука-виробництву», м. Київ, 15-17 травня 2008 р. (участь Інституту було висвітлено у газеті «24» від 17 травня 2008 р., №102);
 - 14-17 травня 2008 року було організовано та успішно проведено Всеукраїнський фестиваль науки, приурочений до професійного свята науковців – Дня науки та присвячений 90-річчю від дня заснування НАН України;
 - Загальнодержавна виставкова акція «Барвіста Україна», м. Київ, 20-23 серпня 2008 р.;
 - 6-й Міжнародний промисловий салон «Авіасвіт XXI» (аеродром «Київ-Антонов», м. Гостомель), 25-29 вересня 2008 р.;
 - Міжнародна виставка «Світ високих технологій», м. Київ, 1-3 жовтня 2008 р.;
 - I Міжнародна виставка лабораторного обладнання, меблів, матеріалів і послуг «LABCOMPLEX», м. Київ, 1-3 жовтня 2008 р.;
 - Міжнародна виставка систем та засобів безпеки «Безпека 2008», м. Київ, 21-24 жовтня 2008 р.
- У 2009 р.:**
- Ювілейна виставка науково-технічних розробок, присвячена 90-річчю НАН України, м. Київ, 25-27 листопада 2008 р.;
 - 14-17 травня 2009 року було організовано та успішно проведено Всеукраїнський фестиваль науки, приурочений до професійного свята науков-

ців – Дня науки;

- Виставка НАН України «Наука — виробництву», м. Київ, 14-16 травня 2009 р.;

- XX Харбінський Міжнародний торгово-економічний ярмарок, 12-22 червня 2009 р. (КНР, м. Харбін);

- Загальнодержавна виставкова акція «Барвіста Україна», м. Київ, 20-23 серпня 2009 р.;

- Міжнародна виставка «Нанотехнології-2009», м. Київ, 30 вересня -3 жовтня 2009 р.;

- Міжнародна виставка «Високі технології», м. Київ, 30 вересня -3 жовтня 2009 р.;

- Міжнародна виставка лабораторного обладнання, меблів, матеріалів і послуг «LABComplex», м. Київ, 30 вересня -3 жовтня 2009 р.;

- Міжнародна виставка систем та засобів безпеки «Безпека 2009», м. Київ, 2-5 листопада 2009 р.

- **У 2010 р.:**

- Виставка –конференція «Медична лабораторія та інновації в медицині», 20-21 квітня 2010 р.;

- 17-19 травня 2010 року було організовано та успішно проведено Всеукраїнський фестиваль науки, приурочений до професійного свята науковців

– Дня науки;

- Виставка НАН України «Наука — виробництву», м. Київ, 14-19 травня 2010 р.

За участь у вищезазначених загальнодержавних та міжнародних заходах Інститутом були отримані відповідні дипломи.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Інститут має багаторічні активні зв'язки з науковими установами багатьох країн. Крім традиційних спільних досліджень з фізичними інститутами, університетами та електронними промисловими підприємствами Росії та інших країн СНД, в останні роки активно розвивалося співробітництво з відомими науковими центрами ФРН, Англії, Франції, Італії, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Японії, Бельгії, Польщі, Угорщини та інших країн. В першу чергу, це дослідження з фізики і оптики квантоворозмірних напівпровідникових систем, опто- та наноелектроніки, фізики поверхні та мікроелектро-

ніки, напівпровідникового матеріалознавства.

Щорічно понад 100 науковців Інституту виїжджають за кордон у наукові відрядження для виступів з науковими доповідями, стажування, участі у роботі конференцій, семінарів та виконання спільних досліджень у зарубіжних лабораторіях. Багато зарубіжних колег із різних країн щорічно відвідують наш Інститут.

З метою налагодження, розширення та відновлення безпосередніх довгострокових відносин із закордонними науковими центрами та академіями постійно підписуються договори на проведення спільних наукових досліджень.

Науковці Інституту беруть участь у виконанні зарубіжних контрактів, грантів міжнародних та зарубіжних організацій, проводять наукові дослідження для реалізації міжнародної російсько-української програми «Нанофізика і наноелектроніка».

Протягом останніх років спільно із зарубіжними науковими установами проводились, зокрема, такі наукові роботи:

- з Фізико-технічним інститутом ім. Йоффе РАН (м. Санкт-Петербург, Росія):

- досліджено електронний транспорт та механізми струмопереносу в наноструктурах A_3B_5 з тунельним зв'язком в залежності від спектру електронних збуджень;

- з'ясовано фізичні механізми впливу компонентної неоднорідності та структурних дефектів на процеси самоіндукованого формування A^2B^6 наострівців та їх електрофізичні та оптичні характеристики (випромінювальну рекомбінацію носіїв заряду, екситон-фононну взаємодію, фононні збудження). Встановлено вплив процесів інтердифузії і сегрегації атомів на фундаментальні фізичні властивості та характеристики нанорозмірних систем на основі сполук A_2B_6 ;

- з Фізико-технічним інститутом ім. Йоффе РАН (м. Санкт-Петербург, Росія) та Фізичним інститутом РАН (м. Москва, Росія) виявлено прояв квантово-розмірного ефекту в електронному оже-процесі в наночастинках. Визначено його вплив на ефективність випромінювання світла і емісії електронів в наночастинках Si, Ge, CdS. Розроблено рекомендації із технології виготовлення наночастинок з високим квантовим виходом фотолюмінесценції у видимій області спектру;

- з фізичним факультетом Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова розроблено плазмово-деформаційну модель утворен-

ня нанорозмірних упорядкованих структур на поверхні CdTe при опроміненні наносекундними імпульсами рубінового лазера;

- з Інститутом фізики напівпровідників СВ РАН (м. Новосибірськ, Росія): встановлено вплив температури росту самоорганізованих GeSi-наноострівців на величини енергії прямих оптичних переходів та виявлено особливості розсіювання на згортках акустичних фононів в надгратках з шарами GeSi-острівців; методами магнетронного осадження виготовлено тонкі плівки кристалічного та аморфного германію на кремнієвих шарах систем КНІ та кремнієвих підкладках і відпрацьовані режими відпалу систем для отримання шарів $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$;

- з Інститутом фізики мікроструктур РАН та Інститутом фізики напівпровідників СВ РАН (Росія) методами катодолюмінесценції та фото-ЕРС визначено природу дефектів, які виникають в процесі термодинамічно нерівноважного вирощування квантових гетероструктур $\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}/\text{In}_{0.26}\text{Ga}_{0.74}\text{As}/\text{GaAs}$ методом молекулярно-пучкової епітаксії;

- з Інститутом фізики мікроструктур РАН (м. Н.Новгород, Росія) досліджено взаємозв'язок між технологічними параметрами молекулярно-променевої епітаксії та структурними і оптичними характеристиками самоорганізованих GeSi-наноострівців, зокрема, виявлено вплив інтердифузії, підсиленої неоднорідними напруженнями, на форму та розміри острівців, залежність їх критичного об'єму, при якому відбувається перехід від пірамідальної форми наноострівців до куполоподібної;

- з Інститутом фізики твердого тіла напівпровідників НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь) розроблено методику виготовлення орієнтованих заготовок зразків із технологічних буль та встановлено кореляцію оптичної якості буль з технологічними режимами вирощування кристалів A_2B_5 . Встановлено їх область прозорості від 2 до 12 мкм та анізотропію пропускання для напрямків поширення світла вздовж та перпендикулярно до осі [100];

- з Державним університетом ім. Янки Купали (м. Гродно, Білорусь):

розроблено фізичні основи технології синтезу діелектрично ізольованих нанокристалів CdTe та визначено їх оптичні властивості. Змодельовані процеси пасивації поверхні нанокристалів CdTe. Розраховано енергетичні спектри електронних, діркових та екситонних станів в нанокристалах CdTe; експериментально та теоретично досліджено оптичні властивості синтезованих хімічним методом нанокристалів CdTe, поверхня яких пасивована тіогліколевою кислотою;

- з фізико-технічним інститутом НВО «Фізика-Сонце» Академії наук

Республіки Узбекистан (м. Ташкент) вибрано оптимальні режими для дифузії і епітаксії твердих розчинів сполук A_3B_5 з мікро/нанорельєфною межею поділу;

- з Каракалпацьким державним університетом ім. Бердаха (Республіка Узбекистан) проводяться дослідження процесів лазерностимульованого формування нано- та бар'єрних структур в кристалах A_2B_6 та їх твердих розчинах для елементної бази сенсорної техніки;

- з Кишинівським державним університетом (Республіка Молдова) досліджено особливості формування спектра електронних і фононних збуджень в напружених напівпровідникових надгратках (типу $GaP_xAs_{1-x}/GaAs$);

- з Інститутом прикладної фізики Академії наук Республіки Молдови (м. Кишинів, Молдова) виготовлено полімерні поперечноштиті шари на основі аміностиролу та гліцеділметакрилату методом радикальної полімеризації. При ультрафіолетовому опромінюванні з інтенсивністю $E=10-20$ мВт/см² механічні параметри значно підвищуються. Виявлено тонкі ефекти впливу температур та інших чинників;

- з Інститутом технічної фізики і матеріалознавства УАН (м. Будапешт, Угорщина) виготовлено бар'єрні структури Si/hc-SiC способом термообробки в CO;

- з Центральним Інститутом фізичних досліджень УАН (м. Будапешт, Угорщина) електронно-мікроскопічними та нелінійно-оптичними дослідженнями встановлено закономірності формування мікроструктури стекол As_2S_3 в залежності від температури витримки розплаву та швидкості його гартування;

- з Інститутом фізики твердого тіла БАН (м. Софія, Болгарія): проаналізовано вплив мікрохвильової радіації на структуру та електричні властивості Ta_2O_5 -Si-систем;

показано, що опромінення (23 MeV) суттєво змінює співвідношення 4- та 6-членних кілець тетраєдрів SiO_4 у ґратці оксидів кремнію;

досліджено структури та склад перехідного шару (ПШ (SiO^x)) в структурах Si-SiO² з надтонким діелектриком (10-15 нм). Показано, що обробка Si у H-плазмі призводить до ненапруженої структури ПШ;

- з Інститутом низьких температур ПАН (м. Вроцлав, Республіка Польща):

проведено розробку і виготовлено зразки криогенних мікросенсорів та багатофункціональних сенсорів для одночасного вимірювання температури і магнітного поля;

виконано теоретичний аналіз коливальних спектрів кристалів з водневими зв'язками з урахуванням ангармонізму та сильної взаємодії водневих коливань з водневими зв'язками;

– з Інститутом електротехніки Словацької Академії наук (м. Братислава, Республіка Словаччина) розроблено технологію MOCVD для формування квантових точок в бар'єрних структурах A_3B_5 ;

- з Арканзаським університетом (США, м. Fayetteville) встановлено закономірності процесу самоорганізованого зародження nanoострівців у напружених $In_xGa_{1-x}As/GaAs$ гетероструктурах та впливу анізотропних полів пружних деформацій на латеральне впорядкування квантових точок і ниток. Виявлено вплив геометричних та структурних факторів на енергетичний спектр і особливості процесів, що реалізуються за участю електронних, екситонних і фононних збуджень в цих наноструктурах;

разом з Дослідницьким Центром наноматеріалів і нановиробництва університету Південної Флориди (м. Тампа, США) досліджено оптичні та люмінесцентні властивості порошкових наночастинок на основі сполук A_2B_6 для біологічного застосування. Проводились також фотолюмінесцентні дослідження гетероструктур на основі сполук A_3B_5 з квантовими точками;

- з Університетом прикладних наук (м. Вільдау, Німеччина) виготовлено орієнтовані плівки барвників на підкладках ПТФЕ випаровуванням у вакуумі та вивчені їх оптичні властивості;

- з Технічним університетом (м. Дармштадт, Німеччина) розроблено технологію отримання наноструктурованих поверхневих шарів GaAs;

– разом з Науково-дослідним центром Россендорф (м. Дрезден, Німеччина) проводяться дослідження у напрямку розвитку електролюмінесцентних приладів на основі кремнію;

– разом з фізичним факультетом та відділом фізики матеріалів Університету м. Мадрид (Іспанія) проводилось вирощування та структурні і люмінесцентні дослідження наноструктур на основі ZnS;

разом з університетом м. Падова (Італія) проводились дослідження оптичних та структурних властивостей композитних матеріалів на основі кремнію;

Відділ теоретичної фізики Інституту є асоційованим членом Міжнародного Центру з Теоретичної фізики в м.Трієсті (Італія);

разом з Саутгемптонівським та Ліверпульським університетами (м.Саутгемптон та м.Ліверпуль, Велика Британія) проведено дослідження фізичних механізмів формування низькочастотного шуму в надвисокочас-

тотних біполярних КНІ SiGe транзисторах і розроблено методи зменшення цього шуму майже на 3 порядки величини;

разом з Мікроелектронним центром IMEC (м. Льовен, Бельгія) проведено дослідження фізики нових шумових явищ в субмікронних об'ємних та КНІ польових транзисторах, виготовлених за допомогою 0,13 мкм та 90 нм технологій;

у рамках українсько-грецького комплексного проекту виконується комплексна робота з розробки портативного приладу для вимірювання рентгенівського і гамма-випромінювання спільно з такими установами у Греції: Технологічний та освітній інститут Халкіса, Інститут ядерної фізики Національного центру наукових досліджень «Demokritos», Департамент радіоактивності навколишнього середовища Грецької комісії з атомної енергії;

з Науково-дослідним інститутом електроніки Університету префектури Шизуока (м. Хамамацу, Японія) виконуються дослідження з лазерностимульованого легування кристалів CdTe, формування р-п переходів і створення діодів для детекторів іонізуючого випромінювання;

разом з університетом Тохоку (м. Сендай, Японія) розроблено технологію вирощування як ізольованих наночастинок Au, так і 1D-металевих нанодротів на поверхні напівпровідників A_3B_5 та досліджено їх оптичні властивості в області поверхневих плазмонів;

з Національним Політехнічним інститутом (м. Мехіко, Мексика) досліджено оптичні та люмінесцентні властивості структур на основі поруватого SiC;

разом з Національним автономним університетом (м. Мехіко, Мексика) вивчено вплив хімічної та лазерної полімеризації плівок фулеренів C_{60} на Si, на їх морфологію, оптичні і фотоелектричні властивості;

разом з Національним Політехнічним інститутом (м. Мехіко, Мексика) проведені оптичні та структурні дослідження нанокристалів Si, Ge, SiC, введених в матриці різного типу. Показано залежність їх характеристики від режимів одержання та додаткових обробок.

Всі ці та багато інших досліджень відображено у десятках публікацій співробітників Інституту, спільних із зарубіжними колегами.

Науковці Інституту беруть участь у роботі міжнародних і зарубіжних організацій, періодичних наукових видань та комітетів.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії, навчальні посібники та підручники

1961 р.

- С.В.Свечников. Газотроны и тиратроны.- Киев: Гостехиздат УССР, 1961. 317 с.
- С.В.Свечников. Основы технической электроники, ч.1. - Киев: Гостехиздат УССР, 1961. – 480 с.

1962 р.

- С.В.Свечников. Основы технической электроники, ч.2. - Киев: Гостехиздат УССР, 1962. – 480 с.

1965 р.

- С.В.Свечников. Фотодвухполюсники. – Киев: Техніка, 1965. – 280 с.

1966 р.

- Ю.А. Тхорик. Переходные процессы в импульсных полупроводниковых диодах. - Киев: Техніка, 1966. –244 с.

1967 р.

- Ю.О.Тхорик. Технологія і параметри імпульсних напівпровідникових діодів. - Київ: Техніка, 1967. – 164 с.
- М.П.Лисица, Л.И.Бережинский, М.Я.Валах. Волоконная оптика. - Киев: Техніка, 1967. – 279 с.

1968 р.

- В.И.Ляшенко, В.Г.Литовченко, И.И.Степко и др. Электронные явления на поверхности полупроводников. - Киев: Наукова думка, 1968. – 400 с.
- С.В.Свечніков. Оптоелектроніка. - Київ: Техніка, 1968. – 172 с.

1969 р.

- В.П.Клочков, С.В.Свечніков. Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали в мікроелектроніці.- Київ: Техніка, 1969. – 184 с.
- С.В.Свечніков, О.М.Зюганов. Фотопотенціометри. - Київ: Техніка, 1969. – 216 с.

1971 р.

- С.В. Свечников. Элементы оптоэлектроники. - Москва: Советское радио, 1971. – 271 с.

1972 р.

- С.В.Свечников. Принципы микроэлектроники. - Киев: Наукова думка, 1972. – 300 с.
- Р.О.Литвинов. Влияние поверхности на характеристики полупроводниковых приборов. - Киев: Наукова думка, 1972. –116 с.
- М.Р.Lisitsa, L.I.Berezhinski, М.Ya.Valakh. Fiberoptics (Program for Scientific Translation, N.Y.), 1972. – 272 p.

1973 р.

- А.Б. Ройцин. Некоторые применения теории симметрии в задачах радиоспектроскопии.- Киев: Наукова думка, 1973. – 100 с.

1975 р.

- S.V. Svechnikov. Zaklady optoelektroniky. - Praha: SNTL, 1975. – 308 p.
- І.В. Фекешгазі, В.Ф. Когденко. Нелінійна оптика напівпровідників. - Київ: Знання, 1975. – 64 с.

1976 р.

- И.Б.Мизецкая, Л.Д.Буденная, Н.Д.Олейник. Физико-химические основы синтеза полупроводниковых монокристаллов. - Киев: Наукова думка, 1976. – 76 с.

1977 р.

- А.В.Саченко, В.А.Зуев, К.Б.Толпыго. Неравновесные процессы в полупроводниках и полупроводниковых приборах. - Москва: Советское радио, 1977. – 256 с.

1978 р.

- В.Г.Литовченко, А.П.Горбань. Основы физики микроэлектронных систем МДН. - Киев: Наукова думка, 1978. – 316 с.
- А.Ф.Кравченко, В.В.Митин, З.М.Скок. Явления переноса в полупроводниковых пленках. - Новосибирск: Наука, СО, 1978. – 256 с.

- С.В. Свечников, А.К. Смовж, Э.Б. Каганович. Фотопотенциометры и функциональные фоторезисторы. - Москва: Советское радио, 1978. – 184 с.

1979 р.

- В.А.Зуев, Б.Х.Пейхов, А.В.Саченко. Физические основы полупроводниковых приборов. – София: Техника, 1979. – 407 с.
- Ф.Ф.Сизов, Ю.И.Уханов. Магнитооптические эффекты Фарадея и Фогта в применении к полупроводникам. - Киев: Наукова думка, 1979. – 180 с.

1980 р.

- В.А.Тягай, О.В.Снитко. Электроотражение света в полупроводниках. - Киев: Наукова думка, 1980. – 304 с.
- В.Г.Литовченко. Основы физики полупроводниковых слоистых систем. - Киев: Наукова думка, 1980. – 284 с.

1981 р.

- Проблемы физики поверхности полупроводников, под ред. О.В.Снитко. - Киев: Наукова думка, 1981. – 332 с.
- В.Е.Лашкарёв, А.В.Любченко, М.К.Шейнкман. Неравновесные процессы в фотопроводниках. - Киев: Наукова думка, 1981. – 264 с.
- К.Д.Глинчук, В.Г.Грачев, М.Ф.Дейген, А.Б.Ройцин, Л.А.Суслин. Электрические эффекты в радиоспектроскопии. - Москва: Наука, 1981. – 336 с.
- М.П. Лисиця, І.М. Халімонова. Лазерна техніка: досягнення та перспективи розвитку. - Київ: Товариство «Знання» УРСР, 1981. – 64 с.
- А.Н.Зюганов, С.В.Свечников. Инжекционно-контактные явления в полупроводниках. - Киев: Наукова думка, 1981. – 256 с.
- И.М.Дыкман, П.М.Томчук. Явления переноса и флуктуации в полупроводниках. - Киев: Наукова думка, 1981. – 320 с.

1982 р.

- С.И.Пекар. Кристаллооптика и добавочные световые волны. - Киев: Наукова думка, 1982. – 296 с.
- В.Н. Томашик, В.И. Грыцив. Диаграммы состояния систем на основе полупроводниковых соединений A_2B_6 . (Справочник). - Киев: Наукова

думка, 1982. – 168 с.

1983 р.

- Б.А.Нестеренко, О.В.Снитко. Физические свойства атомарно-чистой поверхности полупроводников. - Киев: Наукова думка, 1983. – 264 с.
- С.В.Свечников, А.М.Шквар. Нейротехнические системы обработки информации. - Киев: Наукова думка, 1983. – 222 с.
- В.А. Зуев, В.Г. Попов. Фотоэлектрические МДП-приборы. - Москва: Радио и связь, 1983. – 160 с.
- Ю.А. Тхорик, Л.С. Хазан. Пластическая деформация и дислокации несоответствия в гетероэпитаксиальных системах. - Киев: Наукова думка, 1983. – 304 с.
- Б.Д. Шанина. Динамика двойного электронно-ядерного резонанса. - Киев: Наукова думка, 1983. – 176 с.
- S.I. Pekar. Crystal Optics and Additional Light Waves. The Benjamin/Gumming Publ. Co., Menlo Park, California, 1983. – 540 p.

1984 р.

- А.В. Любченко, Е.А. Сальков, Ф.Ф. Сизов. Физические основы полупроводниковой инфракрасной фотоэлектроники (современные тенденции, новые материалы). - Киев: Наукова думка, 1984. – 256 с.
- В.Н. Соколов, В.А. Кочелап, Б.Ю. Венгалис. Фазовые переходы в полупроводниках с деформационным электрон-фононным взаимодействием. - Киев: Наукова думка, 1984. – 180 с.
- М.П. Лисица, А.М. Яремко. Резонанс Ферми. - Киев: Наукова думка, 1984. – 264 с.
- А.В. Саченко, О.В. Снитко. Фотоэффекты в приповерхностных слоях полупроводников. - Киев: Наукова думка, 1984. – 232 с.

1985 р.

- Физические основы полупроводниковой электроники, под ред. О.В. Снитко. - Киев: Наукова думка, 1985. – 304 с.
- М.В. Синьков, В.Д. Сапрыкин, В.Г. Чалая. Многоэлементные детекторы ионизирующего излучения. - Киев: Техніка, 1985. – 134 с.
- В.Л. Громашевский. Нелинейные акустоэлектронные устройства и их применение. - Москва: Радио и связь, 1985. – 160 с.
- В.Н. Добровольский, В.Г. Литовченко. Перенос электронов и дырок у

поверхности полупроводников. - Киев: Наукова думка, 1985. – 192 с.

1986 р.

- М.П.Лисиця, І.М.Халімонова. Лазери в науці і техніці. - Київ: Наукова думка, 1986. – 168 с.
- Р.В. Конакова, Ю.А. Тхорик, Ф. Штофаник. Прогнозирование надежности полупроводниковых лавинных диодов. - Киев: Наукова думка, 1986.- 188 с.
- И.Б. Мизецкая, Г.С. Олейник, Л.Д. Буденная, В.Н.Томашик, Н.Д.Олейник. Физико-химические основы синтеза монокристаллов полупроводниковых твердых растворов соединений A_2B_6 . - Киев: Наукова думка, 1986. – 160 с.
- В.А. Кочелап, С.И. Пекар. Теория спонтанной и стимулированной хемилюминесценции газов. - Киев: Наукова думка, 1986. – 264 с.

1987 р.

- В.И. Гавриленко, А.М. Грехов, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко. Оптические свойства полупроводников (справочник). - Киев: Наукова думка, 1987. – 608с.
- С.В.Свечников, В.П.Кожемяко, Л.И.Тимченко. Квазиимпульсно потенциальные оптоэлектронные элементы и устройства логико-временного типа. - Киев: Наукова думка, 1987. – 256 с.
- П.И. Баранский, И.С.Буда, И.В.Даховский. Теория термоэлектронных и термомагнитных явлений в анизотропных полупроводниках. - Киев: Наукова думка, 1987. – 272 с.

1988 р.

- В.Е.Примаченко, О.В.Снитко. Физика легированной металлами поверхности полупроводников. - Киев: Наукова думка, 1988. – 232 с.
- Л.И. Даценко, В.Б. Молодкин, М.Е. Осинковский. Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами. - Киев: Наукова думка, 1988. – 200 с.
- С.И. Пекар. Избранные труды. - Киев: Наукова думка, 1988. – 512 с.
- Библиография ученых УССР: С.И. Пекар - Киев: Наукова думка, 1988 - 37с.
- А.Н. Марченко, С.В. Свечников, А.К. Смовж. Полупроводниковые сенсорные потенциометрические элементы. - Москва: Радио и

связь, 1988. – 192 с.

- Е.А. Сальков. Основы полупроводниковой фотоэлектроники. - Киев: Наукова думка, 1988.- 280 с.
- Г.С. Свечников. Интегральная оптика. - Киев: Наукова думка, 1988. – 168 с.

1989 р.

- В.А. Nesterenko, O.V. Snitko. Physical properties of atomically clean semiconductor surface. - Moscow: Nauka, 1989. – 336 p.
- И.А. Измайлов, Л.Ю. Мельников. Механизмы электронной хемилюминесценции газов. - Москва, 1989. – 140 с.
- Н.Л. Дмитрук, В.Г. Литовченко, В.П. Стрижевский. Поверхностные поляритоны в полупроводниках и диэлектриках. - Киев: Наукова думка, 1989. – 376 с.

1990 р.

- Н.Б. Лукьянчикова. Флуктуационные явления в полупроводниках и полупроводниковых приборах. - Москва: Радио и связь, 1990. – 296 с.
- В.М. Иващенко, В.М. Митин. Моделирование кинетических явлений в полупроводниках. Метод Монте-Карло. - Киев: Наукова думка, 1990. – 192 с.
- Б.А. Нестеренко, В.Г. Ляпин. Фазовые переходы на свободных гранях и межфазных границах в полупроводниках. - Киев: Наукова думка, 1990. – 152 с.

1991 р.

- V.N. Dobrovolsky, V.G. Litovchenko. Surface Electronic Transport Phenomena in Semiconductors Surface. -Clarendon Press, Oxford 1991. – 220 p.
- Л.Е.Шелимова, В.Н.Томашик, В.И.Грыцив. Диаграммы состояния в полупроводниковом материаловедении (системы на основе халькогенидов Si, Ge, Sn, Pb).- Москва: Наука, 1991. – 368 с.

1992 р.

- Ф.Т.Васько. Электронные состояния и оптические переходы в полупроводниковых гетероструктурах. - Киев: Наукова думка, 1992. – 190 с.
- Радиоспектроскопия твердого тела (Сб. науч. трудов). Отв. ред.

- А.Б.Ройцин. - Киев: Наукова думка, 1992. – 632 с.
- А.Б. Ройцин, В.М. Маевский. Радиоспектроскопия поверхности твердых тел. - Киев: Наукова думка, 1992. – 272 с.
 - П.І.Баранський, І.С.Буда, В.В.Савяк. Термоелектричні і термомагнітні явища в багатодолінних напівпровідниках. - Київ: Наукова думка, 1992. – 272 с.
 - И.З.Индутный, М.Т.Костышин, О.П.Касярум. Фотостимулированные взаимодействия в структурах металл-полупроводник. - Киев: Наукова думка, 1992. – 240 с.
 - Г.Гарягдыев, Й.Завалин, А.Любченко. Слои теллурида кадмия. - Ашхабад, 1992. – 188 с.
 - О.В. Вакулєнко, М.П. Лисица. Оптическая перезарядка примеси в полупроводниках. - Киев: Наукова думка, 1992. – 206 с.
 - С.В.Свєчников, В.В.Химинец, Н.И.Довгошей. Сложные некристаллические халькогениды и халькогалогениды и их применение в оптоэлектронике. - Киев: Наукова думка, 1992. – 296 с.

1993 р.

- И.И.Бойко. Кинетика электронного газа, взаимодействующего с флуктуационным потенциалом. - Киев: Наукова думка, 1993. – 288 с.

1994 р.

- В.Ф.Мачулин, В.И.Хрупа. Рентгеновская диагностика структурного совершенства слабо искаженных кристаллов. - Киев: Наукова думка, 1994. – 268 с.
- Е. Ф. Венгер, М.Грендал, В.Данишка, Р.В. Конакова, И.В. Прокопенко, Ю. А. Тхорик, Л.С. Хазан. Структурная релаксация в полупроводниковых кристаллах и приборных структурах. Механизмы релаксации, методы исследования, роль в деградации приборов. - Киев: Феникс, 1994. – 247 с.

1995 р.

- F.F. Sizov. Колективна монографія «Infrared Photon Detectors» (SPIE Optical Engineering Press, USA Semiconductor Superlattices and Quantum Well Detectors. - Bellingham (USA), 1995. – 561-623 p.
- J.P. Colinge, V.S. Lysenko, A.N. Nazarov. Physical and Technical Problems of SOI Structures and Devices. Eds., NATO ASI Series, Vol. 4,

Kluwer Academic Publishers», 1995. – 290 p.

1996 p.

- M.Ya. Valakh, S.V. Svechnikov, F.F. Sizov. Optics in Ukraine. (SPIE -Ukrainian Chapter), 1996. – 318 p.

1997 p.

- N.B.Lukyanchikova. Noise Research in Semiconductor Physics. Gordon and Breach Science Publishers, 1997. – 411 p.
- И.И. Бойко. Аналитический маркетинг. - Киев: Таксон, 1997. – 11 с.

1998 p.

- В.М.Бабич, Н.И.Блецкан, Е.Ф.Венгер. Кислород в монокристаллах кремния. - Киев: Интерпресс ЛТД, 1998. – 240 с.
- A.E.Belyaev, J.Breza, E.F.Venger, M.Vesely, I.Yu.Ill'in, R.V.Konakova, J.Liday, V.G.Lyapin, V.V.Milenin, I.V.Prokopenko, Yu.A. Tkhorik. Radiation Resistance of GaAs-based Microwave Schottky-barrier Devices. («Радіаційна стійкість надвисокочастотних приладів із бар'єром Шоттки на основі GaAs») (Деякі фізико-технологічні аспекти). - Київ: Інтерпрес ЛТД, 1998. – 128 с.
- Коллективная монография. Радиоспектроскопия конденсированных сред, ч.1. - Киев: ИФП НАН Украины, 1998. – 240 с.
- Л.М.Сусликов, В.Ю.Сливка, М.П.Лисица. Твердотельные оптические фильтры на гиротропных кристаллах. - Киев: Интерпрес ЛТД, 1998. – 293 с.
- F.T.Vasko, A.V.Kuznetsov. Electron States and Optical Transitions in Semiconductor Heterostructures. - Springer, N.Y., 1998. – 400 p.

1999 p.

- Е.Ф.Венгер, Р.В.Конакова, Г.С.Коротченков, В.В.Миленин, З.В.Руссу, И.В.Прокопенко. Межфазные взаимодействия и механизмы деградации в структурах металл-InP и металл-GaAs. – Киев: КНТК, ОАО «Книжная типография научной книги», 1999. – 234 с.
- V.V.Mitin, V.A.Kochelap, M.A.Stroscio. Quantum Heterostructures. - Cambridge University Press, 1999. – 642 p.
- И.И.Бойко, С.И.Козловский. Основы аналитического маркетинга. –

Київ: Видавничий дім «KM Academia», 1999. – 410 с.

- Є.Ф.Венгер, А.В.Гончаренко, М.Л.Дмитрук. Оптика малих частинок і дисперсних середовищ. – Київ: Наукова думка, 2001 – 348 с.

2000 р.

- П.І.Баранський, А.В.Федосов, Г.П.Гайдар. Фізичні властивості кристалів кремнію та германію в полях ефективного зовнішнього впливу. - Луцьк: Надстир'я, 2000.
- Д.В.Корбутяк, С.В.Мельничук, Є.В.Корбут, М.М. Борисюк. Телурид кадмію. Домішково-дефектні стани та детекторні властивості. Київ: Іван Федорів, 2000. – 198 с.
- Колективна монографія в 2 частинах, ч.ІІ. Радиоспектроскопія конденсированных сред.- Київ: 2000.
- P. Hemment, V.S. Lysenko, A.N. Nazarov. Perspectives, Science and Technologies for Novel Silicon on Insulator Devices. NATO Science Ser. 3, Vol.73. - Kluwer Academic Publishers, 2000. – 344 p.

2001 р.

- Є.Ф.Венгер, О.В.Мельничук, Ю.А.Пасічник Спектроскопія залишкових променів. - Київ: Наукова думка, 2001. – 192 с.

2002 р.

- Л.И. Даценко, В.П. Кладько, В.Ф.Мачулин, В.Б. Молодкин. Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами в области аномальной дисперсии. - Киев: Академперіодика, 2002. – 282 с.
- A.E. Belyaev, E.F. Venger, I.B. Ermolovich, R.V. Konakova, P.M. Lytvyn, V.V. Milenin, I.V. Prokopenko, G.S. Svechnikov, E.A. Soloviev, L.L. Fedorenko. Effekt of Microwave and Laser Radiations on the Parameters of Semiconductor Structures. - Kiev: Intas, 2002. – 192 p.
- F. Balestra, A.N. Nazarov, V.S. Lysenko. Progress in SOI Structures and Devices Operating at Extreme Conditions. NATO Science Ser. II, Vol.58, Dordrecht Kluwer, 2002. – 351 p.
- N.B.Lukyanchykova. Sources of the Lorentzian components in the low-frequency noise spectra of submicron metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (глава 10 у книзі «Noise and Fluctuation control in Electronic Devices»). Ed. A. Balandin, American Scientific Publishers,

2002. – 408 р.

- V.V. Basanets, N.S. Boltovets, L.V. Kasatkin, A.V. Zorenko, A.E. Belyaev, R.V. Konakova, V.V. Milenin, D.I. Voitsikhovskiyi. Design, simulation, fabrication and study of oscillator modules for microwave integrated circuits. В кн: Micromachined microwave devices and circuits. Editors: D. Dascalu, H. Hartnagel, R. Plana, A. Muller. - Bucuresti: Editura Academiei Romane, 2002. – 29 р. (глава монографії).
- S.Ostapenko, N.E.Korsunkaya, M.K.Sheinkman. Ultrasound stimulated defect reactions in semiconductors. Chapter VII in «Defect interaction and clustering in semiconductors». Ed. S. Pizzini. - Zurich, Switzerland. - Scitec Publication Ltd., 2002. – 24 р. (глава монографії).
- М.П. Лисиця, М.Я. Валах. Занимательная оптика. Атмосферная и космическая оптика. – Киев: Логос, 2002. – 256 с.
- М.Г. Находкін, Ф.Ф. Сизов. Елементи функціональної електроніки. Навч. посіб. - Київ: ВПФ УкрІНТЕІ, 2002. – 324 с.

2003 р.

- В.В. Петров, А.А. Крючин, С.М. Шанойло, С.А. Костюкевич, В.Г. Кравец, А.С. Лапчук. Оптические диски: история, состояние, перспективы развития. – Київ: НАН України, 2003. – 174 с.
- V.G. Bebeshko, L.A. Darchuk, T.T. Volodina, V.D. Drozdova, L.V. Zaverbna, E.M. Bruslova. Physicochemical changes of osteon characteristics for persons, exposed to ionizing radiation after Chernobyl accident and patients with leukemia. Health effects of Chernobyl accident: - Kiev: DIA, 2003. - 519 р.
- Г.П. Пека, О.В. Третяк, В.В. Кислюк. Збірник задач з фізики напівпровідників. – Київ: Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2003. – 89 с.
- Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. Курс фізики: у 3 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Навч. посіб. – Київ: Вища школа, 2003. – 375 с.
- Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. Курс фізики: у 3 кн. Кн. 2. Електрика і магнетизм: Навч. посіб. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с.
- Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. Курс фізики: у 3 кн. Кн. 3. Оптика. Фізика атома та атомного ядра. Навч. посіб. – Київ: Вища школа, 2003. – 311 с.
- Є.Ф. Венгер, В.М. Горбань, О.В. Мельничук. Основи квантової

механіки. Навч. посіб. – Київ: Вища школа, 2003. – 286 с.

- Є.Ф. Венгер, В.М. Горбань, О.В. Мельничук. Збірник задач з квантової механіки. Навч. посіб. – Київ: Вища школа, 2003. – 230 с.
- М.П. Лисица, Е.Ф. Венгер. Занимательная оптика. Физиологическая оптика. Мир людей. – К.: Вища школа, 2003. – 222 с.: ил.

2004 р.

- A.A. Akopyan, O.Yu. Borkovskaya, N.L. Dmitruk, A.V. Karimov, R.V. Konakova, V.V. Milenin, A.V. Sachenko, M.N. Tursunov, D.M. Yodgorova. Photoconverters with AlGaAs/GaAs heterojunction on textured GaAs substrates (Physico-Technological aspects). - Tashkent: Fan Publishers, 2004. – 178 p.
- Є.Ф. Венгер, В.М. Горбань, О.В. Мельничук. Основи статистичної фізики і термодинаміки. – Київ: Вища школа, 2004. – 255 с. (підручник).
- V. L'vov and V. Lozovski. Seminars in Quantum Mechanics Elementary Problems of Quantum Mechanics in One Dimension. – Київ: Видавництво КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. – 52 с. (підручник).
- Є.Ф. Венгер, Л.Ю. Мельничук, О.В. Мельничук. Фізика на основі експерименту. Лабораторний практикум. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 179 с.
- П.І. Глод, О.Т. Шиманська, Р.М. Мельник, Г.Ю. Рудько. Практикум з механіки. – Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2004.

2005 р.

- O.E. Rajchev, F.T. Vasko. Quantum Kinetic Theory and Applications: Electrons, Photons, Phonons. – Springer, 2005. – 800 p.
- D. Flanre, A.Nazarov, P. Hemment. Science and Tehnology of Semiconductor-on-Insulator Structures and Devices Operating under a Harsh Invironment. – Holland: Kluwer Academic Publishers, 2005. – 348 p.
- В.Б. Молодкин, А.И. Низкова, А.П. Шпак, В.Ф. Мачулин, В.П. Кладько, И.В. Прокопенко, Р.Н. Кютт, Е.Н. Кисловский, С.И. Олиховский, И.М. Фодчук, А.А. Дышеков, Ю.П. Хапачев. Дифрактометрия наноразмерных дефектов и гетерослоев кристаллов. - Киев: Академперіодика, 2005. – 388 с.
- М.П. Бойко, Є.Ф. Венгер, О.В. Мельничук. Фізико-технічна творчість школярів. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 123 с.: іл.

(навчальний посібник).

- М.П. Бойко, Є.Ф. Венгер, О.В. Мельничук. Фізико-технічна творчість учнів. – Київ: Вища школа, 2005. – 254 с. (навчальний посібник).

2006 р.

- В.П. Кладько, В.Ф. Мачулін, Д.О. Григор'єв, І.В. Прокопенко. Рентгенооптичні ефекти в багат шарових періодичних квантових структурах - Київ: Наукова думка, 2006. – 287 с.
- М.П. Лисица, М.Я. Валах. Занимательная оптика. Физиологическая оптика. Мир животных. – К.: Логос, 2006, - 512 с.: ил.
- О.В. Третяк, В.З. Лозовський. Основи сучасної фізики напівпровідників. Навч. посіб. – Київ: Видавництво Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2006.
- V.G.Litovchenko, A.A.Evtukh. Vacuum Nanoelectronics. In Handbook of Semiconductor Nanostructures and Nanodevices. V.3. Spintronics and Nanoelectronics. Edited by A.A.Balandin and K.L.Wang. Los Angeles: American Scientific Publishers. – 2006. P.153 – 234 (довідник).

2007 р.

- М.П. Бойко, Є.Ф. Венгер, О.В. Мельничук. Фізико-технічна творчість учнів. Навчальний посібник. – Київ: Вища школа, 2007. – 262 с.: іл.
- Є.Ф. Венгер, Л.Ю. Мельничук, О.В. Мельничук. Лабораторний практикум з механіки. Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. - 226 с.
- V.V. Mitin, V.A. Kochelap, M. Stroschio. Introduction to Nanoelectronics: Science, Nanotechnology, Engineering and Applications. Cambridge University Press, 2007.

2008 р.

- О.М.Єфанов, В.П.Кладько, В.Ф.Мачулін, В.Б. Молодкін. Динамічна дифракція Х-променів у багат шарових структурах (монографія). – Київ: Наукова думка, 2008.- 227 с.
- О.А.Агєєв, О.Є. Бєляєв, М.С. Болтовець, Р.В. Конакова, В.В.Міленін, В.А. Пилипенко. Фази проникнення в технології напівпровідникових приладів і НВІС. Під заг. ред. проф. Р.В. Конакової. – Харків: НТК «Інститут монокристалів», 2008.- 392 с.
- Ф.Ф.Сизов. Фотоэлектроника для систем видения в невидимых

участках спектра. – Киев: Академперіодика, 2008.- 460 с.

- М.П. Лисица, М. Я. Валах. Занимательная оптика. Физиологическая оптика. Биоллюминесценция. - К.: Логос, 2008, - 165 с.: ил.

2009 р.

- И.И.Бойко. Перенос носителей заряда в полупроводниках. – Киев: НАН Украины, 2009. – 188 с.
- В.В.Петров, А.А.Крючин, С.М.Шанойло, В.Г.Кравець, І.О.Косско, Є.В.Беляк, А.С.Лапчук, С.О.Костюкевич. Надщільний оптичний запис інформації. – НАН України, Інститут проблем реєстрації інформації. – Київ: 2009. – 280 с.
- Г.С.Свечников, А.Н.Морозовская. Нанотрубки и графен – материалы электроники будущего. –Киев: Логос, 2009. – 170 с.
- T.V.Torchynska, L.V.Shcherbyna. SiC nanocrystal structures. – 72 p. T.V. Torchynska, Yu.Vorobiev. Nanocrystals and quantum dots of group IV semiconductors. – American Scientific Publishers, 2009. – 319 p.
- N.L.Dmitruk, A.V.Goncharenko, E.F.Venger. Optics of small particles and composite media. – Київ: 2009. – 386 с.

Щорічно понад 400 наукових статей співробітників Інституту публікуються у провідних виданнях України та зарубіжжя.

НАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ

Ленінська премія

1966 р. - За цикл работ «Теоретические и экспериментальные исследования экситонов в кристаллах» (Э.И. Рашба)

Державні премії СРСР

1984 р. - За разработку и освоение новых радиоэлектронных приборов (М.К.Шейнкман)

1986 р. - За разработку приборов некогерентной оптоэлектроники с высокими технико-экономическими показателями, их промышленное освоение и широкое внедрение в народное хозяйство (С.В. Свечников)

Премія Ради Міністрів СРСР

1983 р. - За розробку нових технологій